### PATENT COOPERATION TREATY

# **PCT**

# TRANSLATION INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference  13584 Ko/mk	FOR FURTHER ACTION	See Form PCT/IPEA/416				
International application No.	International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)				
PCT/DE2005/000559	30.03.2005	01.04.2004				
International Patent Classification (IPC) or national						
G01L9/00 H01L51/20 G0						
Applicant INFINEON TECHNOLOGIES AG						
This report is the international prelimination and transmitted to the control of the contro	ninary examination report, established by e applicant according to Article 36.	this International Preliminary Examining Authority				
2. This REPORT consists of a total of _	sheets, inc	luding this cover sheet.				
3. This report is also accompanied by A						
	to the International Bureau) a total of	sheets, as follows:				
Barrier of the descrip		neen amended and are the basis for this report and/or				
sheets containing red	ctifications authorized by this Authority (se	ee Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative				
sheets which supers the disclosure in the	sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental					
Box.		·				
b. (sent to the International	Bureau only) a total of (indicate type and n	umber of electronic carrier(s))				
	•	, containing a sequence listing and/or tables				
related thereto, in computer	related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see					
Section 802 of the Administ	rative Instructions).					
4. This report contains indications relati	ng to the following items:	•				
Box No. I Basis of the	report					
Box No. II Priority						
Box No. III Non-establi	shment of opinion with regard to novelty, i	inventive step and industrial applicability				
Box No. IV Lack of uni	ty of invention					
Box No. V  Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: citations and explanations supporting such statement						
Box No. VI Certain documents cited						
Box No. VII Certain defects in the international application						
Box No. VIII Certain observations on the international application						
Date of submission of the demand  Date of completion of this report						
Name and mailing address of the IPEA/EP  Authorized officer						
Ivanic and maining address of the Ir LIVEF	, and the state of					
Facsimile No.	Telephone No.	Telephone No.				

International application No.
PCT/DE2005/000559

Box	No. I		Basis of the report			
1.			to the language, this report is based on the internation der this item.	nal application in the language in w	hich it was filed, unless otherwise	
			eport is based on translations from the original langual is the language of a translation furnished for the purp			
			international search (Rule 12.3 and 23.1(b))			
			publication of the international application (Rule 12.4)			
	,		international preliminary examination (Rule 55.2 and/			
2.	recei	regard iving O, report):	to the elements of the international application, this ffice in response to an invitation under Article 14 are	report is based on (replacement she referred to in this report as "ord	neets which have been jurnished to the iginally filed" and are not annexed to	
		the int	ernational application as originally filed/fornished			
	$\boxtimes$	the de	scription:		•	
		pages	1-20		as originally filed/furnished	
		pages	*	received by this Authority on _		
		pages	*	received by this Authority on		
	$\boxtimes$	the cla	aims:			
		nos.			as originally filed/furnished	
		nos.*		as amended (together	with any statement) under Article 19	
		nos.*	1-15		23.12.2005 With letter	
		nos.*				
	X	the dr	awings:			
	KJ	sheets	=		as originally filed/furnished	
		sheets				
		sheets				
	П					
		a sequ	nence listing and/or any related table(s) - see Supplem	ental Box Relating to Sequence Li	sung.	
3.		The a	mendments have resulted in the cancellation of:			
			the description, pages			
			the claims, nos.			
l			the drawings, sheets/figs			
ŀ			the sequence listing (specify):			
			any table(s) related to sequence listing (specify):			
4.		This	report has been established as if (some of) the amend have been considered to go beyond the disclosure as fi	lments annexed to this report and led, as indicated in the Supplemen	listed below had not been made, since tal Box (Rule 70.2(c)).	
l			the description, pages		,	
			the claims, nos.			
			the drawings, sheets/figs			
	the sequence listing (specify):					
	any table(s) related to sequence listing (specify):					
*	If it	em 4 ap	oplies, some or all of those sheets may be marked "sup	erseded."		

International application No.
PCT/DE2005/000559

Bo	Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
1.	Statement					
	Novelty	(N)	Claims	1-15	YES	
			Claims		NO	
	Inventive	e step (IS)	Claims	1-15	YES	
			Claims		NO	
	Industria	d applicability (IA)	Claims	1-15	YES	
			Claims		NO	

2. Citations and explanations (Rule 70.7)

Reference is made to the following document:

D1: SOMEYA T ET AL.: "Integration of organic fiel-effect transistors and rubbery pressure sensors for artificial skin applications" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2003. IEDM. TECHNICAL DIGEST. WASHINGTON, DC, DEC 8-10, 2003, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8 December 2003 (2003-12-08), pages 203-206 XP010683992 ISBN: 0-7803-7872-5

Document D1 is considered to be the closest prior art to the subject matter of claim 1. It discloses (the references between parentheses refer to this document):

a force sensor based on an organic field effect transistor that is supplied to a substrate and has an active layer which acts as a force-sensitive layer and is composed of pentazene, in which a mechanical force which acts on the transistor is transmitted to the active layer which brings about a change in the source-drain voltage which corresponds to this force, or in the source-drain current of the organic field-effect transistor, which changes can be respectively sensed as a measurement

International application No.
PCT/DE2005/000559

Box No. V

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

variable for the acting force.

The subject matter of claim 1 therefore differs from the known force sensor in that the active layer which acts as sensitive to the force is arranged between the source electrode and the drain electrode of the transistor.

The subject matter of claim 1 is thus novel (PCT Article 33(2)).

The problem addressed by the present invention can therefore be considered that of making possible a force sensor which can be manufactured cost effectively.

The solution to this problem, as proposed in claim 1 of the present application involves an inventive step for the following reasons (PCT Article 33(3)):

The international search report citations do not contain any teaching which would prompt a person skilled in the art concerned with the abovementioned problem to change or adapt the force sensor according to document D1 in order to arrive at anything covered by claim 1.

Claims 2-15 are dependent on claim 1 and thus also meet the PCT requirements for novelty and inventive step.

International application No.
PCT/DE2005/000559

Box No. V	I Certain documents cited					***
1. Certa	in published documents (Rule 70.10)					
	Application No. Patent No.		Publication date (day/month/year)	Filing dat (day/month/y		Priority date (valid claim (day/month/year)
			•			
		•				
				•	-	
		÷.				•
			•			
					,	
2. Non-	-written disclosures (Rule 70.9)					
	Kind of non-written disclosure		Date of non-written dis		referring	of written disclosure to non-written disclosure (day/month/year)
				· ·		
	.*					
	•					
						•
				÷		
See s	supplemental sheet					

International application No.
PCT/DE2005/000559

Supplemental Box

In case the space in any of the preceding boxes is not sufficient.

Continuation of:

Box VI

Reference is made to the following document:

D7: WO 2004/077500 A (INFM INSTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA; BONFIGLIO, ANNALI)

10 September 2004 (2004-09-10)

It is to be noted that the priority date (2002-02-28) and the application date (2004-02-27) of the international patent application D7 occur before the priority date of the present application and that the subject matter of claims 1-9 of the present application is disclosed by this document (see the corresponding text references given in the international search report).

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# PCT

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 13584 Ko/mk  WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT//PEA/416						
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmelde						
PCT/DE2005/000559 30.03.2005 01.04.2004						
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation ur	nd IPC					
INV. G01L9/00 H01L51/20 G06F3/033 G06K9/00						
Anmelder						
INFINEON TECHNOLOGIES AG et al.						
<ol> <li>Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</li> </ol>						
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließli	ch dieses Deckblatts.					
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfa						
a. 🛭 (an den Anmelder und das Internationale Büro ge						
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berlchtig 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvors	doder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht gungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel chriften).					
<ul> <li>Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber a Gründen nach Auffassung der Behörde eine A internationalen Anmeldung in der ursprünglich</li> </ul>	aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und Im Zusatzfeld angegebenen Anderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der Deingereichten Fassung hinausgeht.					
h ☐ (nur an das Internationale B()ro gesandt) insgesan	nt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s)					
angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie Im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).						
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:						
☑ Feld Nr. I Grundlage des Berichts						
☐ Feld Nr. II Priorität						
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens übe Anwendbarkeit	r Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche					
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung						
Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung						
☑ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen						
Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen	-					
Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung						
Datum der Einreichung des Antrags	Datum der Fertigstellung dieses Berichts					
12.12.2005	11.08.2006					
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde	Bevollmächtigter Bediensteter					
Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2  NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas  Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo ni	Debesset, S					

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000559

	Feld Nr. I	I Grundlage des Berichts				
1.	. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf					
	⊠ der ir	nternationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.				
	es sid I in I Ve	r Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der ich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: aternationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b))  deröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a))  aternationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a))				
2.	Anmeldea	ch der <b>Bestandteile*</b> der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf <i>(Ersatzblätter, die dem</i> amt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als glich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):				
	Beschreib	bung, Selten				
•	1-20	in der ursprünglich eingereichten Fassung				
	Ansprüch	ie, Nr.				
	1-15	eingegangen am 23.12.2005 mit Schreiben vom 23.12.2005				
	Zeichnung	gen, Blätter				
	1/5-5/5	in der ursprünglich eingereichten Fassung				
	☐ einen Sequenzp	m Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das protokoll				
3,	☐ Be ☐ Ar ☐ Ze ☐ Se	rund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: eschreibung: Seite nsprüche: Nr. eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : twaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :				
4.	aufgeliste Auffassun (Regel 70	er Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend eiten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach ing der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen 0.2 c)).  eschreibung: Seite insprüche: Nr. eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll (genaue Angaben): twaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):				
		Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung				

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000559

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen -Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-15

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-15

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja:

Ansprüche: 1-15

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

### Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

 Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) und / oder

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)

siehe Beiblatt

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000559

### Zu Punkt V

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: SOMEYA T ET AL: "Integration of organic field-effect transistors and rubbery pressure sensors for artificial skin applications" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2003. IEDM. TECHNICAL DIGEST. WASHINGTON, DC, DEC 8 - 10, 2003, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8. Dezember 2003 (2003-12-08), Seiten 203-206, XP010683992 ISBN: 0-7803-7872-5

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

einen Kraftsensor auf der Basis auf einem Substrat aufgebrachten organischen Feldeffekttransistors mit einem als kraftsensitive Schicht wirkenden aktiven Schicht aus Pentazen, bei dem sich eine auf den Transistor einwirkende mechanische Kraft auf die aktive Schicht überträgt, die eine dieser Kraft entsprechende Änderung der Source-Drainspannung oder des Source-Drainstroms des organischen Feldeffekttransistors verursacht, die jeweils als Messgröße für die einwirkende Kraft erfassbar sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten Kraftsensor dadurch, daß die als Kraftsensitive einwirkende aktive Schicht zwischen der Sourceelektrode und der Drainelektrode des Transistors angeordnet ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, einen kostengünstig herstellbaren Kraftsensor zu ermöglichen.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

In den im internationalen Recherchenbericht zitierten Dokumenten findet sich keine Lehre,

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000559

die den mit der obengenannten Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde, den Kraftsensor nach Dokument D1 so zu ändern oder anzupassen, um zu etwas zu gelangen, was unter den Anspruch 1 fällt.

Die Ansprüche 2-15 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

### Zu Punkt VI

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D7: WO 2004/077500 A (INFM ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA; BONFIGLIO, ANNALI) 10. September 2004 (2004-09-10)

Es muss festzustellen, daß der Prioritätstag (2002-02-28) und der Anmeldetag (2004-02-27) des internationalen Patentanmeldung D7 vor dem Prioritätstag der vorliegenden Anmeldung liegt, und daß der Gegenstand der Ansprüche 1-9 der vorliegenden Anmeldung von diesem Dokument offenbart wird (siehe die entsprechenden im internationalen Recherchenbericht angegebenen Textstellen).

Internationale Patentanmeldung Nr. PCT/DE2005/000559
Infineon Technologies AG

13584

23.12.2005

### Neuer Patentansprüche

- 1. Kraftsensor auf der Basis auf einem Substrat (1; 11) aufgebrachten organischen Feldeffekttransistors (10) mit einer als kraftsensitive Schicht wirkenden aktiven Schicht (5) aus Pentazen, Fluoren oder Thiopen zwischen seiner Sourceelektrode (7) und seiner Drainelektrode (4), bei dem sich eine auf den Transistor einwirkende mechanische Kraft auf die aktive Schicht (5) überträgt, die eine dieser Kraft entspre-
- chende Änderung der Source-Drainspannung oder des Source-Drainstroms ( $I_D$ ) des organischen Feldeffekttransistors (10) verursacht, die jeweils als Messgröße ( $V_{mess}$ ,  $I_{mess}$ ) für die einwirkende Kraft erfassbar sind.
- 3. Kraftsensor nach Anspruch 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Polymerfolie des Substrats (1) insbesondere Polyethylen-Naphthalat (PEN), Polyethylen-Terephthalat (PET), Polyimid (PI), Polycarbonat und/oder Polyethenether-Ketone
  (PEEK) aufweist.
- 4. Kraftsensor nach einem der vorangehenden Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, dass die erfasste Messgröße (Vmess) die Drain-Source-Spannung des organischen Feldeffekttransistors (10) ist, wobei diesem zum Messzeitpunkt eine konstante Gate-Source-Spannung (Vsteuer) und ein konstanter Drain-Strom (Isteuer) anliegen.

10

ř.

Internationale Patentanmeldung Nr. PCT/DE2005/000559
Infineon Technologies AG

13584

23.12.2005

- 5. Kraftsensor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dad urch gekennzeich net, dass die erfasste Messgröße der Drainstrom ( $I_{mess}$ ) des organischen Feldeffekttransistors (10) ist, wobei diesem zum Messzeitpunkt eine konstante Gate-Source-Spannung ( $V_{steuer1}$ ) und eine konstante Drain-Source-Spannung ( $V_{steuer2}$ ) anliegen.
- 6. Drucksensor unter Verwendung wenigstens eines Kraftsensors nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Substrat als deformierbare Membran (11) gestaltet ist und die Messgröße dem Biegezustand der Membran entspricht.
- 7. Ein- oder zweidimensionaler Positionssensor zur Messung der Position einer mechanischen Krafteinwirkung entlang einer Linie oder innerhalb einer Fläche unter Verwendung einer Vielzahl von Kraftsensoren (10<sub>1</sub>, 10<sub>2</sub>, ..., 10<sub>n</sub>) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Kraftsensoren (10<sub>1</sub>, 10<sub>2</sub>, ..., 10<sub>n</sub>) in regelmäßigen Abständen zueinander in Form einer ein- oder zweidimensionalen Matrix auf einem gemeinsamen Substrat angeordnet sind.
- 8. Eindimensionaler Positionssensor nach Anspruch 7,
  d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
  dass eine Ansteuer- und Messeinheit (20) mit den Drain- oder
   Sourceanschlüssen aller Feldeffekttransistoren zur Ansteuerung und Erfassung der Position der Krafteinwirkung verbunden bzw. verbindbar ist.
- 9. Zweidimensionaler Positionssensor nach Anspruch 8,
  30 bei dem die organischen Feldeffekttransistoren in Zeilen und
  Spalten angeordnet sind und eine Ansteuer- und Messeinheit
  (20) mit den Drain- oder Sourceanschlüssen aller Spalten zur
  Ansteuerung und Erfassung der Spaltenposition der Krafteinwirkung und ein Zeilendecoder (21) mit den Gateanschlüssen
  35 der organischen Feldeffekttransistoren zur zeilenweisen Auswahl und Ansteuerung der organischen Feldeffekttransistoren
  verbunden bzw. verbindbar sind.

Internationale Patentanmeldung Nr. PCT/DE2005/000559
Infineon Technologies AG

13584

3 23.12.2005

- Fingerabdrucksensor unter Verwendung einer Vielzahl von in Form einer in Zeilen und Spalten untergliederten zweidimensionalen Matrix in regelmäßigen Abständen auf einem gemeinsamen Substrat angeordneten Kraftsensoren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei eine Ansteuer- und Messeinheit (70) mit den Drain- oder Sourceanschlüssen der organischen Feldeffekttransistoren in allen Spalten zur Ansteuerung und Erfassung der Spaltenposition der Krafteinwirkung und ein Zeilendecoder (21) mit den Gateanschlüssen der organischen Feldeffekttransistoren aller Zeilen zur zeilenweisen Auswahl und Erfassung der Position der Krafteinwirkung in Zeilenrichtung verbunden bzw. verbindbar sind.
  - 11. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 10,
- dass wenigstens eine schweißresistente Schutzschicht (30, 31; 32) als Schutz gegen Eindringen von Wasser und organischen Kontaminationen über der aktiven Schicht (5) der organischen Feldeffekttransistoren vorgesehen ist.

20

12. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 11, dad urch gekennzeich net, dass die Schutzschicht aus einem perfluorierten Material besteht.

25

- 13. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine erste Schutzschicht (30) aus einem hydrophoben Material und eine zweite Schutzschicht (31) aus einem hydrophilen Polymer besteht, das als Diffusionsbarriere gegen lipophile Verunreinigungsstoffe wirkt.
  - 14. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
- dass die erste Schutzschicht (30) die zweite Schutzschicht (31) bedeckt.

Internationale Patentanmeldung Nr. PCT/DE2005/000559
Infineon Technologies AG

13584

23.12.2005

15. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 13, dad urch gekennzeich net, dass die zweite Schutzschicht (31) die erste Schutzschicht (30) bedeckt.

5